2N7002

SURFACE MOUNT SILICON N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET

SOT-23 CASE

Central Semiconductor Corp.

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N7002 type is an N-Channel enhancement-mode MOSFET manufactured by the N-Channel DMOS Process, designed for high speed pulsed amplifier and driver applications.

MARKING CODE: 702

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)	**SYMBOL**		**UNITS**
Drain-Source Voltage	V_{DS}	60	V
Drain-Gate Voltage	V_{DG}	60	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	40	V
Continuous Drain Current (T_C=25°C)	I_D	115	mA
Continuous Drain Current (T_C=100°C)	I_D	75	mA
Continuous Source Current (Body Diode)	I_S	115	mA
Maximum Pulsed Drain Current	I_{DM}	800	mA
Maximum Pulsed Source Current	I_{SM}	800	mA
Power Dissipation	P_D	350	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	°C
Thermal Resistance	Θ_{JA}	357	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (T_A=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	**TEST CONDITIONS**	**MIN**	**TYP**	**MAX**	**UNITS**
I_{GSSF}	V_{GS}=20V			100	nA
I_{GSSR}	V_{GS}=20V			100	nA
I_{DSS}	V_{DS}=60V, V_{GS}=0			1.0	μA
I_{DSS}	V_{DS}=60V, V_{GS}=0, T_A=125°C			500	μA
$I_{D(ON)}$	V_{DS}=10V, V_{GS}=10V	500			mA
BV_{DSS}	I_D=10μA	60	105		V
$V_{GS(th)}$	V_{DS}=V_{GS}, I_D=250μA	1.0	2.1	2.5	V
$V_{DS(ON)}$	V_{GS}=10V, I_D=500mA			3.75	V
$V_{DS(ON)}$	V_{GS}=5.0V, I_D=50mA			0.375	V
V_{SD}	V_{GS}=0, I_S=11.5mA			1.5	V
$r_{DS(ON)}$	V_{GS}=10V, I_D=500mA		3.7	7.5	Ω
$r_{DS(ON)}$	V_{GS}=10V, I_D=500mA, T_A=100°C			13.5	Ω
$r_{DS(ON)}$	V_{GS}=5.0V, I_D=50mA		6.2	7.5	Ω
$r_{DS(ON)}$	V_{GS}=5.0V, I_D=50mA, T_A=100°C			13.5	Ω
g_{FS}	V_{DS}=10V, I_D=200mA	80			mS

R6 (9-February 2015)

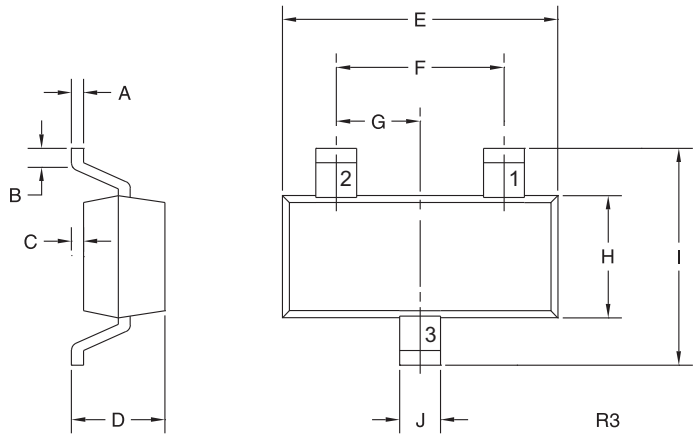
2N7002

SURFACE MOUNT SILICON N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: (T_A=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYP	MAX	UNITS
C_{rss}	V_{DS}=25V, V_{GS}=0, f=1.0MHz		5.0	pF
C_{iss}	V_{DS}=25V, V_{GS}=0, f=1.0MHz		50	pF
C_{oss}	V_{DS}=25V, V_{GS}=0, f=1.0MHz		25	pF
$Q_{g(tot)}$	V_{DS}=30V, V_{GS}=4.5V, I_D=100mA	0.592		nC
Q_{gs}	V_{DS}=30V, V_{GS}=4.5V, I_D=100mA	0.196		nC
Q_{gd}	V_{DS}=30V, V_{GS}=4.5V, I_D=100mA	0.148		nC
t_{on}	V_{DD}=30V, I_D=200mA, R_G=25Ω, R_L=150Ω		20	ns
t_{off}	V_{DD}=30V, I_D=200mA, R_G=25Ω, R_L=150Ω		20	ns

SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE



LEAD CODE:
1) Gate
2) Source
3) Drain

MARKING CODE: 702

DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50

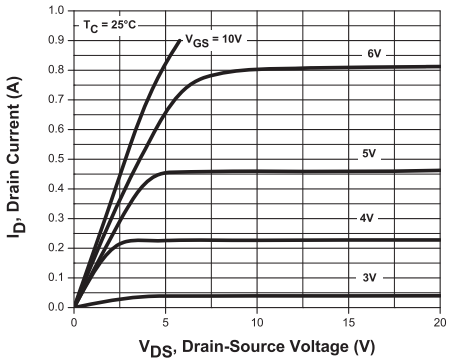
SOT-23 (REV: R3)

2N7002

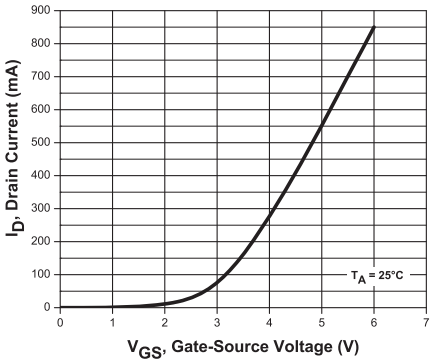
SURFACE MOUNT SILICON N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

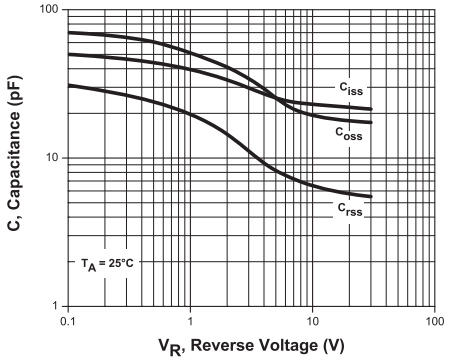
Output Characteristics



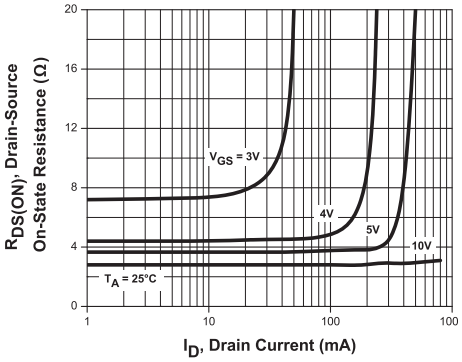
Transfer Characteristics



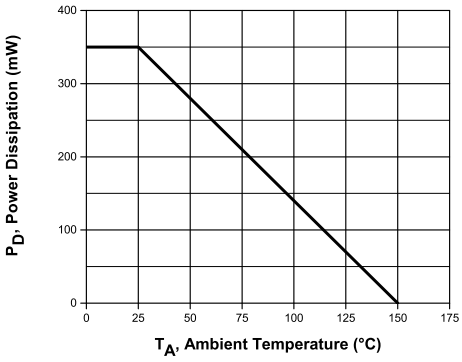
Capacitance



Drain Source On Resistance



Power Derating



R6 (9-February 2015)

2N7002

SURFACE MOUNT SILICON N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET

SERVICES

- Bonded Inventory
- Custom Electrical Screening
- Custom Electrical Characteristic Curves
- SPICE Models
- Custom Packaging
- Package Base Options
- Custom Device Development / Multi Discrete Modules (MDM™)
- Bare Die Available for Hybrid Applications

R6 (9-February 2015)

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9